

2002 P 74473

B5

(12) NACH DEM VERTRÄG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
18. Januar 2001 (18.01.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 01/04964 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L 31/18, 31/032, 31/0392
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE (ETH) [CH/CH]; ETH Zentrum, CH-8092 Zürich (CH).

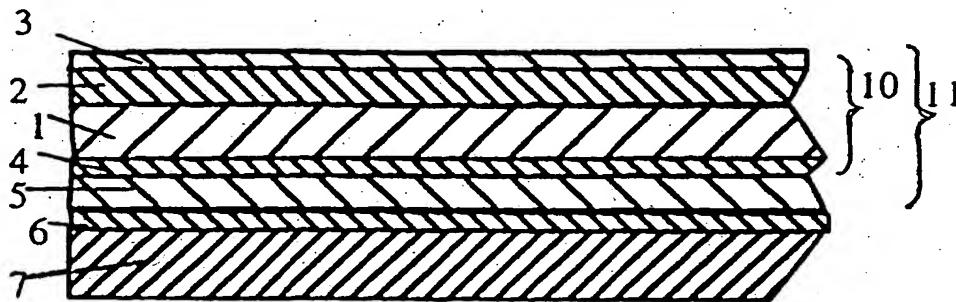
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/CH00/00379
(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): TIWARI, Ayodhya, N. [IN/CH]; Hirzenbachstrasse 82, CH-8051 Zürich (CH). KREJCI, Martin [CH/CH]; Kinkelstrasse 10, CH-8006 Zürich (CH). HAUG, Franz, Josef [DE/CH]; Hofwiesenstrasse 235, CH-8057 Zürich (CH). ZOOG, Hans [CH/CH]; Weierackerstrasse 1, CH-8114 Dänikon (CH).

(22) Internationales Anmeldedatum: 12. Juli 2000 (12.07.2000)
(25) Einreichungssprache: Deutsch
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
(30) Angaben zur Priorität: 1287/99 13. Juli 1999 (13.07.1999) CH (74) Anwalt: DILTEC AG; Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich (CH).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: FLEXIBLE THIN-LAYER SOLAR CELL

(54) Bezeichnung: FLEXIBLE DÜNNSCHICHT-SOLARZELLE



(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a flexible thin-layer solar cell. An intermediate layer (6), known as a sacrificial layer, for example NaCl, is applied to a rigid substrate (7) and a carrier layer (5), for example, a polyimide is deposited thereon. Additional layers are then deposited onto the support layer, for example, Mo (4), a CuIn_xGa_yS_zSe_u absorber (1) with x, y, z, u ≥ 0, a CdS-ZnO window layer (2) and a transparent front contact (3), the structuring of the cells is completed and they are optionally provided with a coating. The solar cell structure is separated from the rigid substrate (7) by the dissolution of the sacrificial layer, whereby the resultant solar cell becomes flexible. The invention relates to flexible solar cells produced by this method which have typical thicknesses of 25 µm with approximately 13 % effectiveness. Large-surface cells can be used for energy production both on earth and in space, whilst small-surface cells can be used for powering electronic goods, such as for example, pocket calculators and smart cards.

WO 01/04964 A1

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer flexiblen Dünnschicht-Solarzelle. Auf ein starres Substrat (7) wird eine Zwischenschicht (6), eine sogenannte Opferschicht; z.B. NaCl aufgebracht und darauf eine Trägerschicht (5), z.B. ein Polyimid, abgeschieden. Darauf werden die weiteren Schichten, z.B. Mo (4), CuIn_xGa_yS_zSe_u-Absorber (1) mit x, y, z, u ≥ 0, CdS-ZnO Fensterschicht (2) und transparenter Frontkontakt (3) abgeschieden, die Zellen fertig strukturiert und eventuell mit einer Deckschicht versehen. Die Solarzellenstruktur wird durch Auflösen der Opferschicht vom starren Substrat (7) getrennt, wobei die resultierende Solarzelle flexibel wird. Auf diesem Verfahren basierende flexible Solarzellen werden beschrieben und weisen typische Dicken von 25 µm auf bei einer Effizienz von ca. 13 %. Anwendungen sind für grossflächige Zellen Energieproduktion auf der Erde und im Weltraum, für kleinflächige Zellen Speisung elektronischer Güter wie z.B. Taschenrechner und "smart cards".



(81) Bestimmungsstaaten (*national*): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI,

FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— Mit internationalem Recherchenbericht.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Flexible Dünnschicht-Solarzelle

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Solarzellen sowie eine Solarzelle, die nur aus dünnen Schichten besteht und flexibel ist, gemäss den Patentansprüchen 1 und 8.

Die bisher bekannten flexiblen Solarzellen wurden direkt auf Metallfolien oder Kunststofffolien produziert. Bei der Verwendung von Kunststofffolien ergaben sich Probleme mit der Kompatibilität zwischen Kunststoff und eigentlicher Solarzellenstruktur wegen der beschränkten Temperaturstabilität von Polymeren. Weiter können wegen dieser beschränkten Temperaturstabilität und inhomogenen Spannungsverteilungen in den Folien unbrauchbare Oberflächen resultieren, sowie, falls die elektrisch aktiven Schichten mit Vakuumabscheidetechniken aufgebracht werden, lokale Fehler in der Oberfläche zu katastrophalen Kurzschlüssen in den fertigen Zellen führen. Bei Verwendung von Metallfolien kann die Rauigkeit der Folienoberfläche zu Problemen führen (B.M. Basol et al., 25th IEEE Photovol. Spec. Conf. 1988, IEEE Service Center, New York, USA, 1996, S. 157-162; M.A. Contreras et al., "Fabrication methods of Cu(In,Ga)Se₂ polycrystalline materials and devices currently under development at the national renewable energy laboratory", Proc. 14th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Barcelona, Spain, 1997, H.S. Stephens & Associates, UK, 1997, S. 2354-2358).

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zur Herstellung von Solarzellen anzugeben, bei dem eine auflösbare Zwischenschicht die Trennung der Solarzelle von einem starren Träger erlaubt.

Eine weitere Aufgabe besteht darin, eine Solarzelle vorzuschlagen, die nur aus dünnen Schichten besteht und flexibel ist.

Erfindungsgemäss werden diese Aufgaben mit einem Verfahren gemäss dem Wortlaut des Patentanspruches 1 und einer Solarzelle gemäss dem Wortlaut des Patentan-

spruches 8 gelöst. Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Figuren näher erläutert. Es zeigen:

- Fig. 1 Schichtstapel vor dem Ablösen vom starren Substrat
- Fig. 2a Schichtstapel einer zweiten Version vor dem Ablösen vom Substrat
- Fig. 2b Schichtstapel der zweiten Version im fertigen Zustand
- Fig. 3 Schichtstapel für "Superstratkonfiguration" vor dem Ablösen vom starren Substrat

Fig. 1 zeigt einen Schichtstapel vor dem Ablösen vom starren Substrat an Hand dessen das Verfahren beschrieben wird.

Auf ein starres Substrat 7, das z.B. aus Glas, Keramik oder Metall besteht, wird eine lösliche Zwischenschicht 6 z.B. durch Vakuumverdampfen aufgebracht. Diese lösliche Zwischenschicht, eine sogenannte "Opferschicht", besteht z.B. aus Kochsalz (NaCl) oder BaF₂, beide Substanzen sind in Wasser löslich. Als Lösungsmittel wird deshalb zu gegebener Zeit im Herstellungsverfahren Wasser verwendet. Auf das mit der löslichen Zwischenschicht 6 bedeckte Substrat 7 wird nun die Trägerschicht 5 aufgebracht, z.B. eine durch Vakuumabscheidung deponierte Metallschicht, oder eine z.B. aufgeschleuderte Polymerschicht wie z.B. ein kommerziell unter dem Markennamen "Kapton" erhältlicher temperaturresistenter Kunststoff.

Auf die Trägerschicht 5 wird nun eine Folge von Schichten 1 - 4, ein sog. Schichtpaket 10, aufgebracht, das Halbleiter als elektrisch aktive Schichten benutzt, welcher die elektronisch/optisch nötigen Schichten der Solarzelle enthält. Alle Schichten werden während der Herstellung auf einem starren Substrat mit Abscheidetechniken oder auch sonstwie angebracht.

Die weiteren Verfahrensschritte werden am Beispiel einer CuIn_xGa_ySe_z mit x,y,z ≥ 0 (im folgenden CIGS) Solarzelle erläutert; die Beschreibung kann sinngemäss auch für andere Zellentypen wie z.B. CdTe angewendet werden. Für die CIGS Zelle entsprechen die weiteren Schritte im wesentlichen den schon bekannten Verfahren (H.W. Schock and A. Shah, "Status and prospects of photovoltaic thin film technologies", Proc. 14th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Barcelona, Spain, 1997, H.S. Stephens & Associates, UK, 1997, S. 2000-2005): Auf die

Trägerschicht (5) wird der Rückkontakt (4) abgeschieden, dieser besteht z.B. aus aufgesputtertem Mo. Mit den bekannten Techniken, z.B. durch simultanes oder sequentielles Vakuumabscheiden der in der CIGS-Verbindung enthaltenen Elemente Cu, In, Ga und Se, wird die Absorberschicht (1) von wenigen Mikrometern Dicke aufgebracht, hier können die bekannten Techniken angewendet werden, durch z.B. Graduierung der Schichtzusammensetzung eine möglichst hohe Effizienz der fertigen Zelle zu erhalten. Die Temperatur der Probe während der Abscheidung beträgt z.B. 400°C. Bei dieser Temperatur bleibt eine geeignete Kunststoffträgerschicht wie oben beschrieben noch intakt, aber es können trotzdem Zellen mit hohen Effizienzen erhalten werden. Ebenfalls kann bei diesem Schritt etwas Na in geeigneter Form und/oder Verbindung beigegeben werden, da bekannt ist, dass eine Na-Beigabe sich positiv auf die Eigenschaften der fertigen Zelle auswirkt. Auf die Na-Beigabe kann auch verzichtet werden, dies z.B. falls Na bereits durch die Zwischenschicht, sofern diese Na-haltig ist, in der nötigen Menge und Form geliefert wird. Darauf folgt die Deposition der Fensterschicht (2), die z.B. aus ZnO, CdS oder ZnSe besteht, und des Frontkontakte (3) aus z.B. ITO (Indium-Zinn-Oxid), wobei je nach gewähltem Verfahren weitere Differenzierungen wie z.B. CdS-Abscheidung, oder Dotierung des oberen Teils der Fensterschicht, dass diese gleichzeitig auch als Frontkontaktteil fungiert, sinnvoll sind. Je nach lateraler Grösse der Struktur werden durch z.B. Ritzen oder Photolithographie einzelne Solarzellen strukturiert und allenfalls Antireflexions- und mechanische Schutzschichten (z.B. eine optisch transparente UV-beständige weitere Polymerschicht) aufgebracht.

Zu diesem Zeitpunkt der Fertigungssequenz kann nun typischerweise die Zwischenschicht 6 aufgelöst werden, wodurch das Substrat 7 von der Trägerschicht 5 und dem darauf aufgebrachten Schichtpaket 10 getrennt wird. Die Trägerschicht 5 und das Schichtpaket 10 bilden die nun flexible Solarzelle.

Falls die Zwischenschicht 6 z.B. aus NaCl oder BaF₂ besteht, kann Wasser als Lösungsmittel verwendet werden. Für nicht wasserlösliche Zwischenschichten oder auch aus anderen Gründen können andere Lösungsmittel verwendet werden.

Mit diesem erfindungsgemässen Verfahren wurde z.B. eine CIGS-Solarzelle mit 12.8 % Effizienz auf einem Polyimid-Substrat erhalten. Die Schichtdicke des aufgesponne-

nen Polyimides betrug ca. 20 μm , die Dicke der für das elektrisch-optische Funktionieren der Solarzelle wesentlichen Schichten weniger als ca. 4 μm . Die ganze Struktur ist flexibel und kann für die bereits beschriebenen Anwendungen eingesetzt werden.

Diese Prozedur bringt gegenüber bestehenden bekannten Herstellungsverfahren verschiedene Vorteile: Die Herstellung von solchen Schichtstrukturen ist meist einfacher und reproduzierbarer, wenn die Schichten auf starre Träger abgeschieden werden z.B. kann so die für hohe Effizienz der Zellen optimale Abscheidetemperatur besser kontrolliert werden. Weiter ist die dünne Trägerfolie nie alleine den allenfalls mit ihren Eigenschaften schlecht kompatiblen Bedingungen während der Schichtabscheidungen ausgesetzt, wie z.B. hohe Temperatur und/oder mechanische Spannungen. Weiter können wegen mechanischen Spannungsinhomogenitäten in der Folie Fehler oder Inhomogenitäten in den aufgewachsenen Schichtstrukturen entstehen, die zu katastrophalen elektrischen Kurzschlägen führen können.

Das starre Substrat 7 kann nach dem Ablösen der Schichtstruktur 11 wiederverwendet werden.

Wesentlich an der erfindungsgemässen Solarzelle ist somit, dass sie während eines Grossteils der Herstellungsschritte auf einem starren Substrat entsteht, von diesem anschliessend abgelöst wird und danach jedoch flexibel ist. Sie kann im flexiblen Zustand verwendet werden, aber auch mit einem weiteren festen Substrat wieder verbunden werden.

Gute Dünnschichtsolarzellen aus meist polykristallinen Verbindungshalbleitern wie z.B. $\text{CuIn}_x\text{Ga}_y\text{Se}_z$ mit $x,y,z \geq 0$ (meist mit CIGS abgekürzt) weisen z.Z. bereits sehr hohe Effizienzen auf (12% - 18%), diese können mit denen von konventionellen Solarzellen aus einkristallinem Silizium verglichen werden. Die für die Zellfertigung benötigten Schichten werden meist auf starre Glassubstrate aufgewachsen. Die Dicke der elektrisch wesentlichen Schichten beträgt nur wenige Mikrometer; pro Quadratmeter Solarzellenfläche werden dadurch nur wenige Gramm Material benötigt. Die Herstellungskosten werden bei Massenproduktion wesentlich geringer als die von

kristallinen Siliziumzellen ausfallen.

Für einige Anwendungen ist es vorteilhaft, wenn die gesamte Solarzellenstruktur flexibel bleibt. Dies z.B. um das relativ teure Glassubstrat zu umgehen, die Solarzellen auf gekrümmte Flächen wie Fassaden, Ziegel oder auch gekrümmte Gehäuse von elektronischen Konsumgeräten anzubringen, oder auch nur um Gewicht einzusparen, was besonders für Weltraumanwendungen wichtig ist. Ebenso kann eine grossflächige flexible Struktur zum Transport einfach gerollt werden. Aber auch für kleinflächige Anwendungen sind flexible Solarzellen interessant, z.B. als Energiequelle für Taschenrechner oder "smart cards", welche integrierte elektrische Schaltkreise und auch Displays enthalten können, aber gewissen Flexibilitätsanforderungen genügen müssen.

Fig. 2a und 2b zeigen eine Variation des erfindungsgemässen Herstellungsverfahrens. Fig. 2a zeigt einen zweiten Schichtstapel vor dem Ablösen vom Substrat. Zur Herstellung wird hier wie bereits beschrieben die Zwischenschicht 6 auf das Substrat 7 aufgebracht. Auf die Trägerschicht 5 wird jedoch zum momentanen Herstellungszeitpunkt verzichtet, sondern direkt die weiteren Schichten 1 - 4 der Solarzellenstruktur abgeschieden, also z.B. wie bereits beschrieben Rückkontakt 4 (z.B. Mo) gefolgt von CIGS 1, welches eventuell mit etwas Na versehen wird, Fensterschicht 2 und Frontkontakt 3. Darauf wird nun das transparente Polymer 5 als Trägerfolie aufgebracht, und die ganze Struktur 11 durch Auflösen der Zwischenschicht 6 vom starren Substrat 7 gelöst. Bei dieser Variante kann die Abscheidetemperatur auch höher als 400°C sein, da ja die Polymerschicht erst nachträglich aufgebracht wird; ebenfalls kann anstelle des Polymers ein Kunststoff mit weniger guter Temperaturbeständigkeit verwendet werden.

Fig. 2b zeigt einen zweiten Schichtstapel im fertigen Zustand. Erkennbar ist die in Fig. 2a beschriebene Schichtsstuktur 11 und eine weitere Schicht 8, z.B. ein Kunststoff, der als Schutzschicht angebracht werden kann.

Eine weitere Variante ist, das Schichtpaket vor dem Aufbringen der oberen Polyimid-schicht sorgfältig vom starren Träger zu lösen, und erst nachträglich dieses auf eine

transparente Folie aufzubringen, möglicherweise unter Verwendung eines Transport-Zwischensubstrates. In beiden Fällen kann danach auf die Unterseite, d.h. auf die Rückkontakt-Schicht, eine weitere Schutzfolie, die auch der mechanischen Stabilität dienen kann, mit geeigneten Mitteln aufgeklebt oder sonstwie aufgebracht werden. Das flexible Komposit kann auch für gewisse Anwendungen wieder mit einem starren Substrat verbunden werden. Beispielsweise werden für konventionelle CIGS Zellen Glassubstrate in "Substrat-Struktur" verwendet. Für die vollständige Kapselung benötigt man somit zwei Glasscheiben, nämlich eine zweite Glasscheibe, die dem mechanischen und chemischen Schutz der Solarzellenschichten dient und durch die das Licht einfällt. Mit der erfindungsgemässen Solarzelle ist die untere Glasscheibe überflüssig, somit kann eine Scheibe eingespart werden, eine solche Anordnung ist in einer derart rauen oder korrosiven Umgebung sinnvoll, in der licht-transparente Kunststoffabdeckungen ungenügenden Schutz bieten.

Die beiden oben beschriebenen Verfahren entsprechen der in der Fachliteratur beschriebenen "Substrat-Struktur", d.h. die in den konventionellen starren Zellen verwendete Glasschicht als Substrat wird vom Licht nicht durchquert. In der ebenfalls in der Fachliteratur beschriebenen "Superstrat-Struktur" fällt das Licht durch das Glassubstrat ein; bei der konventionellen Herstellungssequenz wird deshalb auf das Glassubstrat der transparente Frontkontakt abgeschieden, gefolgt von der Fensterschicht und den weiteren Schichten. Z.B. wird bei CdTe-Dünnschichtzellen auf Glassubstraten diese Konfiguration vorwiegend angewendet.

Die vorliegende Erfindung kann ebenfalls für die "Superstrat-Konfiguration" eingesetzt werden.

Fig. 3 zeigt einen Schichtstapel für eine "Superstratkonfiguration" vor dem Ablösen vom starren Substrat. Auf das Substrat 7, die Zwischenschicht 6 und die Trägerschicht 5 folgen hier ein transparenter Frontkontakt 3, eine Fensterschicht 2, eine Absorberschicht 1 und ein Rückkontakt 4. Die Herstellungsschritte erfolgen sinngemäss.

Als Zwischenschicht kommt eine grosse Klasse von Materialien in Frage. Viele Alkali-Halogenide, darunter NaCl, NaF, KCl sind geeignet und zudem leicht wasserlöslich,

das selbe gilt für IIa-Fluoride wie BaF_2 . Weitere geeignete Materialien sind alle jene denkbar, die hinreichend temperaturbeständig sind und für die ein Lösungsmittel existiert, das in der betreffenden Umgebung eingesetzt werden darf, ohne dass die Funktionen des Schichtaufbaus gefährdet werden.

Spezielle Beachtung muss der Qualität der Schichten und insbesondere deren Haftung und allfälliger Delaminationerscheinungen geschenkt werden. Die in der Erfindung an Beispielen genannten Strukturen haben auch in der praktischen Realisierung gezeigt, dass, in nicht abschliessender Aufzählung, die Mo-Schicht auf Polyimid als Kontakt-schicht brauchbar ist, die NaCl-Zwischenschicht die Haftung bzw. die weitere Herstellung nicht verunmöglicht, die spezielle aufgesponnene Polyimidschicht die Temperaturen während der Herstellung übersteht und ihre nötigen mechanischen und optischen Eigenschaften bewahrt.

Die für die Formierung der eigentlichen Solarzelle verwendeten Schichten können ebenfalls verschiedene Klassen von Materialien umfassen. Dazu gehören polykristalline Verbindungshalbleiter wie CuInGaSeS . Mit dieser Notation ist $\text{CuIn}_y\text{Ga}_z\text{Se}_w\text{S}_u$ gemeint, wobei die Parameter y, z, w und u beliebige nicht negative Werte haben können, jedoch wie bekannt, für optimale Zellen die Werte auf spezielle kleinere Bereiche beschränkt sind. Diese Materialfamilie umfasst somit Verbindungshalbleiterschichten aus dem I-III-V System der chemischen periodischen Systems, insbesondere gehören dazu (die Parameter y, z, w, und u werden im folgenden nicht mehr niedergeschrieben) CuInSe , CuInGaSe , CuGaSe , CuInS , CuInGaSSe , weitere Materialien können ebenfalls verwendet werden.

Aus der II-VI Familie des chemischen periodischen Systems können CdTe sowie ebenfalls weitere Verbindungen benutzt werden. Ebenfalls können Verbindungen aus der III-V Familie des chemischen periodischen Systems wie z.B. GaAs oder Gruppe IV Halbleiter des chemischen periodischen Systems wie Si oder Ge verwendet werden.

Alle diese Verbindungen liegen in den erfindungsgemässen Solarzelle meist als polykristalline Schichten vor. Die Struktur der Schichten kann jedoch polykristallin, mikrokristallin, nanokristallin, mikromorph oder amorph, wie die in der Fachliteratur genannten Bezeichnungen für verschiedene Strukturen von dünnen Schichten heissen,

sein.

Weiter können anstelle einer Schichtabfolge zur Formation einer einzigen Solarzelle, - die Schichtfolge enthält also mindestens eine Absorberschicht und eine Fensterschicht sowie Kontaktsschichten-, mehrere solche Schichtfolgen aufeinander abgeschieden werden. Werden zwei solche Folgen verwendet, entsteht beispielsweise eine "Tandemzelle", hier passiert das Licht zuerst eine Solarzellenstruktur mit grösserer Bandlücke, danach eine Zellstruktur mit kleinerer Bandlücke, mit dieser Anordnung kann die Ausbeute erhöht werden. Strukturen mit mehr als zwei solcher Schichtfolgen zur Formation von Tripelzellen, oder Mehrfachzellen mit noch mehr solchen Einzel-solarzellen sind ebenfalls möglich.

Der teilweise transparente elektrische Kontakt 3 besteht z.B. aus dem Halbleiter Indium-Zinn-Oxid (ITO) oder ZnO oder Kombinationen aus solchen Schichten, der Rückkontakt 4 kann aus einem Metall oder Halbleiter oder beidem bestehen, wie bekannt ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer Solarzelle, gekennzeichnet dadurch, dass auf einem Substrat (7) eine auflösbare Zwischenschicht (6) aufgebracht wird, dass auf diese Zwischenschicht (6) eine Schichtstruktur (11) aufgebracht wird, dass die Zwischenschicht (6) anschliessend aufgelöst wird, wodurch die Schichtstruktur (11) vom Substrat (7) getrennt wird und dass dadurch aus der Schichtstruktur (11) eine flexible Solarzelle gebildet wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Schichtstruktur (11) aus einer Trägerschicht (5) und einem Schichtpaket (10) gebildet wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Schichtstruktur (11) aus einem Schichtpaket (10) gebildet wird und dass nach dem Auflösen der Zwischenschicht (6) das Schichtpaket (10) mit einer Trägerschicht (5) versehen wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Auflösen der Zwischenschicht (6) das Substrat (7) weiterverwendet wird.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht (6) aus einem Material der Gruppe der Alkali-Halogenide wie NaCl, KCl, NaF oder der Gruppe IIa-Fluoride wie BaF₂ besteht.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Kombinationen von Schichtpaketen (10) mit oder ohne Trennschichten zwischen den Schichtpaketen übereinander abgeschieden werden.
7. Anwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 - 6 zur Energieerzeugung auf der Erde und im Weltraum und für Konsumgüter, wie Taschenrechner und "smart cards".

8. Solarzelle nach einem der Ansprüche 1 - 7, bestehend aus mindestens einer Absorberschicht (1) eines Halbleiters, aus mindestens einer Fensterschicht (2) eines Halbleiters zur Einkoppelung des Lichtes, aus mindestens eines mindestens teilweise transparenten Frontkontakte (3), und mindestens eines Rückkontakte (4), gekennzeichnet dadurch, dass die Solarzelle mindestens eine dünne Trägerschicht (5) aufweist und dass diese an den Rückkontakt (4) angrenzt oder sich auf dem Frontkontakt (3) befindet.
9. Solarzelle nach Anspruch 8, gekennzeichnet dadurch, dass die Trägerschicht (5) aus einem Kunststoff, vorzugweise aus Polyimid, oder aus Metall oder Keramik besteht, und dass sie eine Dicke von 1 - 100 μm , vorzugsweise 20 μm aufweist.
10. Solarzelle nach Anspruch 8 oder 9, gekennzeichnet dadurch, dass die Absorberschicht (1) aus einem Material der Gruppe der I-III-V Verbindungen des periodischen Systems besteht, wie CuIn_xSe_y , $\text{CuIn}_x\text{Ga}_y\text{Se}_z$, $\text{CuIn}_x\text{Ga}_y\text{S}_z\text{Se}_u$ mit $x,y,z,u \geq 0$, oder der II-VI Verbindungen des periodischen Systems CdTe, oder III-V Verbindungen des periodischen Systems wie $\text{Al}_{1-x-y}\text{Ga}_x\text{In}_y\text{As}_{1-u-w}\text{P}_u\text{N}_w$ mit $0 \leq x,y,u,w \leq 1$ oder der Gruppe IV-Elemente des periodischen Systems wie Si oder Ge.
11. Solarzelle nach einem der Ansprüche 8 - 10, gekennzeichnet dadurch, dass die Fensterschicht (2) aus einem Halbleitermaterial mit mindestens gleichgrosser Bandlücke wie die der Absorberschicht (1) besteht, wobei die Struktur der Schichten polykristallin oder amorph ist.
12. Solarzelle nach einem der Ansprüche 8 - 11, gekennzeichnet dadurch, dass die Absorberschicht (1) aus $\text{CuIn}_x\text{Ga}_y\text{S}_z\text{Se}_u$ mit $x,y,z,u \geq 0$ besteht und die Fensterschicht (2) mindestens ein Material aus der Gruppe dotiertem oder undotiertem ZnO, InSnO (ITO), CdS und ZnSe enthält.
13. Solarzelle nach einem der Ansprüche 8 - 12, gekennzeichnet dadurch, dass die flexible Solarzellenstruktur je nach Verwendungszweck ein festes Trägermaterial wie Glas, Metall oder Keramik aufweist.

1 / 1

Fig. 1

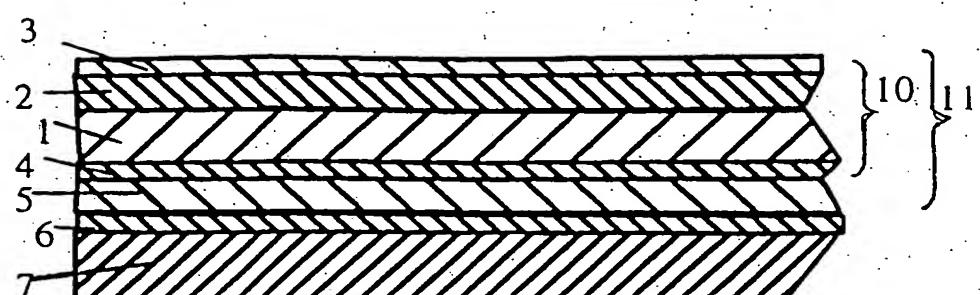


Fig. 2a

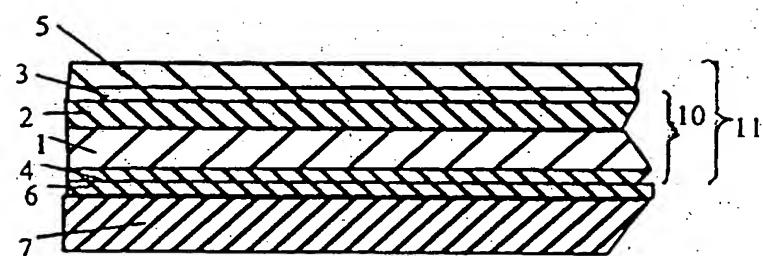


Fig. 2b

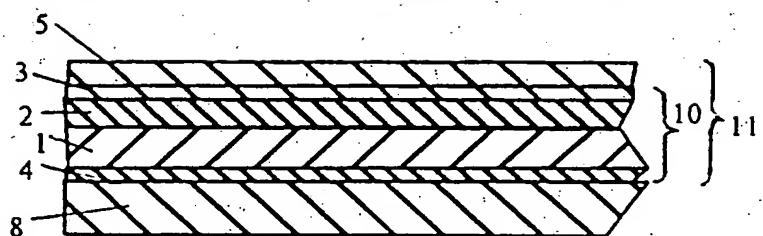
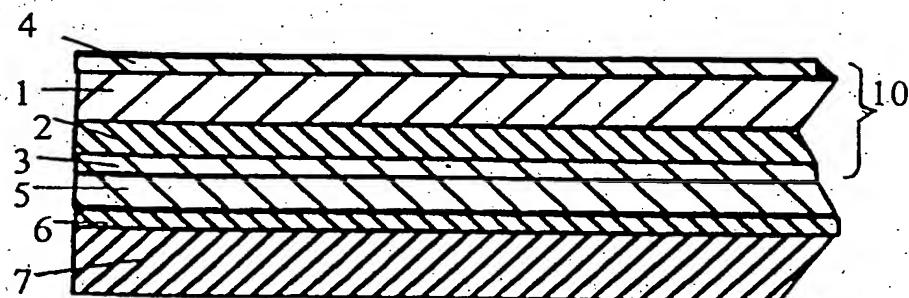


Fig. 3



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/CH 00/00379

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H01L31/18 H01L31/032 H01L31/0392

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

WPI Data, EPO-Internal, INSPEC, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5 232 860 A (KAWANISHI YASUYOSHI ET AL) 3 August 1993 (1993-08-03) the whole document ---	1,2,4, 7-11,13
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 348 (E-659), 19 September 1988 (1988-09-19) & JP 63 107073 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), 12 May 1988 (1988-05-12) abstract ---	1,2,7-11 -/-

Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority, claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

20 September 2000

Date of mailing of the international search report

27/09/2000

Name and mailing address of the ISA
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Visentin, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int'l. Application No
PCT/CH 00/00379

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	BASOL B M ET AL: "FLEXIBLE AND LIGHT-WEIGHT COPPER INDIUM DISELENIDE SOLAR CELLS ON POLYIMIDE SUBSTRATES" SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, NL, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, vol. 43, no. 1, 15 August 1996 (1996-08-15), pages 93-98, XP000627656 ISSN: 0927-0248 the whole document ----	8-13
X	BASOL B M ET AL: "COPPER INDIUM DISELENIDE THIN FILM SOLAR CELLS FABRICATED ON FLEXIBLE FOIL SUBSTRATES" SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, NL, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, vol. 29, no. 2, 1 March 1993 (1993-03-01), pages 163-173, XP000361960 ISSN: 0927-0248 page 163 -page 166 ----	8-13
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 346 (E-798), 3 August 1989 (1989-08-03) & JP 01 105581 A (SANYO ELECTRIC CO LTD), 24 April 1989 (1989-04-24) abstract ----	1,2,4, 7-9
X	DE 24 47 066 A (UNIV DELAWARE) 4 September 1975 (1975-09-04) claims 1-7; figures 1,2 ----	8,9,11
A	LANDIS G A: "A PROCESS SEQUENCE FOR MANUFACTURE OF ULTRA-THIN, LIGHT-TRAPPING SILICON SOLAR CELLS" SOLAR CELLS, ELSEVIER SEQUOIA S.A. LAUSANNE, CH, vol. 29, no. 2 / 03, 1 August 1990 (1990-08-01), pages 257-266, XP000142017 the whole document ----	1-5,7,8, 10
A	EP 0 851 513 A (CANON KK) 1 July 1998 (1998-07-01) ----	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/CH 00/00379

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
US 5232860	A 03-08-1993	JP 2783918	B	06-08-1998
		JP 4299873	A	23-10-1992
JP 63107073	A 12-05-1988	NONE		
JP 01105581	A 24-04-1989	JP 2680582	B	19-11-1997
DE 2447066	A 04-09-1975	AR 199739	A	23-09-1974
		AU 7005674	A	18-12-1975
		BE 817492	A	04-11-1974
		FR 2262863	A	26-09-1975
		JP 50120788	A	22-09-1975
		NL 7410599	A	03-09-1975
EP 0851513	A 01-07-1998	JP 10189924	A	21-07-1998
		JP 10190029	A	21-07-1998
		AU 4926897	A	02-07-1998
		CN 1192055	A	02-09-1998

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/CH 00/00379

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H01L31/18 H01L31/032 H01L31/0392

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H01L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen.

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, EPO-Internal, INSPEC, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 232 860 A (KAWANISHI YASUYOSHI ET AL) 3. August 1993 (1993-08-03) das ganze Dokument	1,2,4, 7-11,13
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 348 (E-659), 19. September 1988 (1988-09-19) & JP 63 107073 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), 12. Mai 1988 (1988-05-12) Zusammenfassung --- -/-	1,2,7-11

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

- * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmelddatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmelddatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

- "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmelddatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

20. September 2000

Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts

27/09/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Visentin, A

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/CH 00/00379

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	BASOL B M ET AL: "FLEXIBLE AND LIGHT WEIGHT COPPER INDIUM DISELENIDE SOLAR CELLS ON POLYMIDE SUBSTRATES" SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, NL, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, Bd. 43, Nr. 1, 15. August 1996 (1996-08-15), Seiten 93-98, XP000627656 ISSN: 0927-0248 das ganze Dokument	8-13
X	BASOL B M ET AL: "COPPER INDIUM DISELENIDE THIN FILM SOLAR CELLS FABRICATED ON FLEXIBLE FOIL SUBSTRATES" SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, NL, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, Bd. 29, Nr. 2, 1. März 1993 (1993-03-01), Seiten 163-173, XP000361960 ISSN: 0927-0248 Seite 163 -Seite 166	8-13
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 346 (E-798), 3. August 1989 (1989-08-03) & JP 01 105581 A (SANYO ELECTRIC CO LTD), 24. April 1989 (1989-04-24) Zusammenfassung	1,2,4, 7-9
X	DE 24 47 066 A (UNIV DELAWARE) 4. September 1975 (1975-09-04) Ansprüche 1-7; Abbildungen 1,2	8,9,11
A	LANDIS G A: "A PROCESS SEQUENCE FOR MANUFACTURE OF ULTRA-THIN, LIGHT-TRAPPING SILICON SOLAR CELLS" SOLAR CELLS, ELSEVIER SEQUOIA S.A. LAUSANNE, CH, Bd. 29, Nr. 2 / 03, 1. August 1990 (1990-08-01), Seiten 257-266, XP000142017 das ganze Dokument	1-5,7,8, 10
A	EP 0 851 513 A (CANON KK) 1. Juli 1998 (1998-07-01)	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Int. nationales Aktenzeichen

PCT/CH 00/00379

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5232860	A	03-08-1993		JP 2783918 B JP 4299873 A		06-08-1998 23-10-1992
JP 63107073	A	12-05-1988		KEINE		
JP 01105581	A	24-04-1989		JP 2680582 B		19-11-1997
DE 2447066	A	04-09-1975		AR 199739 A AU 7005674 A BE 817492 A FR 2262863 A JP 50120788 A NL 7410599 A		23-09-1974 18-12-1975 04-11-1974 26-09-1975 22-09-1975 03-09-1975
EP 0851513	A	01-07-1998		JP 10189924 A JP 10190029 A AU 4926897 A CN 1192055 A		21-07-1998 21-07-1998 02-07-1998 02-09-1998

THIS PAGE BLANK (USPTO)